

# **Пленарные доклады. Микро- и нанотехнологии в электронике ..... 11**

Наноупорядоченные полупроводниковые материалы в современной электронике. <i>Попов А.И., Воронцов В.А., Попов И.А.</i> .....	13
Многообразие фазовых переходов. <i>Камилов И.К.</i> .....	19
Диффузионные процессы в стекле С78-5 при пропускании постоянного электрического тока. <i>Кармоков А.М., Молоканов О.А., Шомахов З.В., Люев В.К., Кармоков М.М.</i> .....	22
Исследование особенностей структуры самоорганизованных нанонеод- нородных функциональных материалов методами рассеяния рентгенов- ских лучей. <i>Филимонов А.В.</i> .....	27
<b>Секция 1. Физико-химические свойства материалов и структур микро- и наноэлектроники .....</b>	<b>37</b>
Магнитные, электрические и термоэлектрические свойства композита $Cd_3As_2 + MnAs$ ( $MnAs - 44,7\%$ ). <i>Гаджиалиев М.М., Сайтулаева Л.А., Мельникова Н.В., Алибеков А.Г., Пирмагомедов З.Ш., Эфендиева Т.Н., Захвалинский В.С., Тебеньков А.В., Суханов Г.В., Маренкин С.Ф.</i> .....	39
Область гомогенности кристаллического три-(8-оксихинолята) индия. <i>Аккузина А.А., Козлова Н.Н., Аветисов Р.И., Аветисов И.Х.</i> .....	43
Структура наноповерхности $Sb_2Te_3$ , $Bi_2Te_3$ на фольге $A^{V_2}B^{VI_3}$ . <i>Маммадо- ва И.Т., Абдуллаев Н.М., Гасанов М.А., Каҳраманов С.Ш., Халилова К.Г.</i> .	47
Российский вклад в исследования стекла: изучение вязкости и решение задач отжига-закалки стекла. <i>Старцев Ю.К.</i> .....	53
Физико-химические основы высокопластических переходов $GeTe -Co_2Se$ . <i>Магеррамов А.А., Каҳраманов С.Ш.</i> .....	62
Время релаксации фоторезисторов на основе халькогенидов свинца. <i>Мирошникова И.Н., Мирошников Б.Н., Зенова Е.В., Пресняков М.Ю.</i> .....	67
Электропроводность аморфных кремний-углеродных пленок на основе кремнийорганических жидкостей. <i>Баринов А.Д.</i> .....	72
Исследование влияние фуллерена $C_{60}$ на светостойкость полиэтилена и полиметилметакрилата. <i>Курбонов Н.Б., Туйчиев Ш.Т., Курбонов Ч.Б., Ахадов А.Р.</i> .....	77
Люминесцентные свойства полупроводниковых квантоворазмерных ча- стиц (ПКЧ) в суспензии и на подложке. <i>Жуков Н.Д., Шишкун М.И., Ка- занов А.А., Дежуров С.В.</i> .....	81
Изучение физико-химических особенностей стеклообразных материа- лов в эпоху нанобума. <i>Старцев Ю.К.</i> .....	86

Исследование поведения структурных характеристик наночастиц металлов вблизи фазового перехода плавление/кристаллизация. Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю., Колосов А.Ю., Соколов Д.Н., Ершов П.М., Непша Н.М., Романовский В.И. ....	92
Активация газочувствительных свойств пленок $\text{SnO}_2:\text{Si}$ с помощью катализаторов и оптического воздействия. Рембеза С.И., Рембеза Е.С., Свистова Т.В., Перепечина Т.А. ....	96
Исследование характеристик гетероструктур $p\text{-Si}/n\text{-ZnO(Al)}$ . Рембеза С.И., Просветов Р.Е., Мокроусов Н.С., Свистова Т.В., Рембеза Е.С. ....	101
Исследование подложек и эпитаксиальных структур карбида кремния бесконтактными методами. Панов М.Ф., Марков А.В., Растворов В.П., Севастьянов Е.Н., Трушлякова В.В. ....	105
Механизм поглощения энергии в композитах металл-диэлектрик в зависимости от частоты сигнала. Соцков В.А., Петров С.А., Ашижев Э.В. ....	116
Радиационно-катализитические процессы разложения воды в присутствии нано-Zr. Агаев Т.Н., Гусейнов В.И. ....	120
Радиационно-катализитические процессы разложения воды в присутствии систем нано-ZrO <sub>2</sub> +нано-SiO <sub>2</sub> . Агаев Т.Н., Меликова С.З. ....	122
Влияние гамма излучения на выход водорода при радиолизе воды в присутствии нано-ZrO <sub>2</sub> . Агаев Т.Н., Иманова Г.Т. ....	127
Дизэлектрические свойства нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полизтилена CdS/ZnS. Магеррамов А.М., Гаджиева Е.Г. ....	130
Гибридный электропроводящий материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и одностенных углеродных нанотрубок. Озкан С.Ж., Карпачева Г.П. ....	133
Анализ вольт-фарадных характеристик структур «электролит-диэлектрик-полупроводник», полученных при фотостимулированной адсорбции поликатионных и полianiонных молекул. Козловский А.В., Стецюра С.В. ....	143
Повышение селективности газовой чувствительности пленок-композитов на основе диоксида олова. Рембеза С.И., Кошелева Н.Н., Перепечина Т.А., Митрохин В.И. ....	148
Физико-химическое исследование системы Cu <sub>2</sub> SnS <sub>3</sub> -ZnS, синтез Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> и их нанотонких пленок для солнечных элементов. Абдулзаде Н.Н., Алиев И.И., Аскерова П.А., Ахмедова Д.А., Заманова А.К., Мурсакулов Н.Н., Сабзалиева Ч.Э. ....	152
Верхнее критическое магнитное поле Bi <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> CaCu <sub>2</sub> O <sub>x</sub> пленки. Рагимов С.С., Агаева Г.И., Багирова С.М. ....	157
Структурные и электрические свойства AgSbTe <sub>2</sub> и AgSbTe <sub>1.5</sub> Se <sub>0.5</sub> . Рагимов С.С., Алиева А.И., Бабаева А.Э., Селим-Заде Р.И. ....	160

Электрофизические свойства твердого раствора $(\text{AgSbTe}_2)_{0.5}(\text{PbTe})_{0.5}$ . Рагимов С.С., Мусаев М.А., Рагимли Н.Х., Гашымова Н.Н. ....	163
Предпереходные состояния ионных материалов в области структурных фазовых переходов. Алиев З.А., Какагасанов М.Г., Алиев А.Р., Ахмедов И.Р. ....	166
Исследование бинарных ионных систем методом комбинационного рассеяния света. Алиев З.А., Какагасанов М.Г., Алиев А.Р., Ахмедов И.Р. ....	171
Пироэлектрическая мишень для регистрации инфракрасного излучения. Хатукаев Х.М., Люев И.В., Молоканов О.А., Кармоков А.М. ....	176
Межфазное натяжение и работа адгезии на границе оксида железа с жидким свинцом. Дышекова А.Х., Кармоков А.М., Молоканов О.А. ....	181
Энергетические потери пучков заряженных частиц вблизи поверхности графена. Тленкопачев М.В., Уначев А.С., Канаметов А.А. ....	185
Investigation the influence of substrate type on the optical properties of CdSe quantum dots monolayer. Al-Alwani A.J.K., Chumakov A.S., Shinkarenko O.A., Begletsova N.N., Gorbachev I.A., Bratashov D.N., Venig S.B., Glukhovskoy E.G. ....	189
Исследование ионно-имплантированных слоев кремния эллипсометрическим методом. Калмыков Ш.А. ....	191
Электрон-эмиссионные свойства полупроводниковых наночастиц. Гавриков М.В., Жуков Н.Д., Мосияш Д.С., Хазанов А.А. ....	202
Механизмы тока в мультизеренной структуре (МЗС) субмикронных полупроводниковых частиц. Жуков Н.Д., Ягудин И.Т. ....	207
Частотно-температурная зависимость диэлектрического отклика в мультиферроике $\text{LuFe}_2\text{O}_4$ . Гамзатов А.Г., Гаджиев Г.М., Алиев Р.А., Абакарова Н.С., Эмирасланова Л.Л., Кауль А.Р., Маркелова М.Н. ....	211
Явления переноса заряда в $\text{TiFeSe}_2$ . Мустафаева С.Н., Керимова Э.М., Матиев А.Х., Бекбузаров И.А. ....	213
Прыжковая проводимость в $\text{TiFeS}_2$ . Мустафаева С.Н., Керимова Э.М., Матиев А.Х., Беков И.И. ....	217
Характер электропроводности облученных кристаллов $\text{TlInS}_2$ . Мадатов Р.С., Наджафов А.И., Матиев А.Х., Котиев С.В. ....	221
Влияние электропереноса на взаимную диффузию и макроскопическое течение в бинарных расплавах, растущих при контактном плавлении. Багов А.М., Тамаев Т.Х., Тебаев И.И. ....	226
Влияние электропереноса на концентрации в бинарных расплавах, образованных при контактном плавлении. Ахкубеков А.А., Багов А.М., Тамаев Т.Х., Тебаев И.И. ....	231
Температурная зависимость тепловых свойств пьезокерамики ПКР-61, ПКР-38. Гаджиев Г.Г., Абдуллаев Х.Х. Омаров З.М., Магомедов М.М., Амиррова А.А., Резниченко Л.А. ....	239

Участие электронных уровней синтина в образовании центров люминесценции. Пицуков А.М., Азизов И.К. ....	244
Люминесцентные явления в органических полупроводниках. Караданова З.И. ....	249
Температурная зависимость удельной электропроводности и термо-ЭДС теллурида свинца с примесями селенида кадмия. Калмыков Р.М., Хутов А.Э., Кармоков А.М. ....	253
<b>Секция 2. Технология получения наноматериалов для электроники</b> ..... <i>Бородин Ю.А., Бондарев С.А., Гладышев А.А.</i>	<b>259</b>
Условия формирования сложных наноформ углерода при кавитации в изопропиловом спирте. Воронаев С.А., Душенко Н.В., Мартынов Л.Ю. ....	261
Технология интеркалированных соединений $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Fe}\rangle$ . Багиров С.Б., Каҳраманов А.Ш. ....	265
Аспектная зависимость скорости глубокого криогенного травления кремния в плазме $\text{SF}_6:\text{O}_2$ . Гущин О.П., Матюшкин И.В., Мицын Н.Г. ....	270
О технологических условиях «выращивания» поверхности с заданными фрактальными свойствами. Соколов Д.Н., Антонов А.С., Сдобников Н.Ю., Иванов Д.В., Подболотов К.Б. ....	275
Исследования влияния формы канала на процессы образования радикалов $\text{AlO}$ в плазме при воздействии серий сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый сплав Д16Т в воздушной атмосфере. Воропай Е.С., Баззал Ходор, Зажогин А.П., Лычковский В.В. ....	281
Процессы при напылении тонких пленок чистого оксида цинка и легированного медью на поверхность стекла сдвоенными лазерными импульсами. Зажогин А.П., Чинь Н.Х., Патапович М.П., Бурайчик Ж.И. ....	284
Исследование влияния ионов железа на процессы фотохимического образования нанокластеров соединений урана переменной валентности в растворах уранилперхлората в ацетоне. Комяк А.И., Вилейшикова Н.П., Зажогин А.П., Комяк Е.Н. ....	288
Влияние технологического режима на электростатическое взаимодействие полупроводниковой структуры и органических молекул. Козловский А.В., Стециора С.В. ....	292
Получение и исследованиеnanoчастиц меди. Беглецова Н.Н., Селифanova Е.И., Чернова Р.К., Глуховской Е.Г. ....	297
Влияние pH субфазы на формирование монослоя ароматических углеводородов. Шинкаренко О.А., Аль-Альвани А.Ж.К., Аргунов Е.В., Ханина А.С., Цветкова О.Ю., Глуховской Е.Г. ....	302
Эффективный контроль технологического процесса микроэлектроники. Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А. ....	305

Совершенствование технологии и изготовления изделий микроэлектроники с минимальной дефектностью. Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.....	308
Исследование технологических особенностей изготовления полупроводниковых варикапов на переходе металл-пористый кремний. Гаев Д.С., Тимошенков С.П., Бойко А.Н., Гаева З.С., Казадаева Е.В., Ибрагим А.С., Башиев А.Х., Кайгермазов А.И.....	312
Получение и исследование нанокомпозитов никель-пористый кремний. Гаев Д.С., Башиев А.Х., Кайгермазов А.И., Гаева З.С., Ибрагим А.С.....	315
Влияние технологических факторов на изменение фазового состава сплавов на основе теллурида свинца. Калмыков Р.М., Кармоков А.М.....	319
Nanocomposite materials for 3D micromechanical components. V. Kurmanshev, I. Timoshkov, A. Sakava, V. Timoshkov .....	323
<b>Секция 3. Приборы и устройства микро- и наноэлектроники, микросистемная техника.....</b>	<b>333</b>
О влиянии освещения при ионном травлении фотопроводника на его состав. Шишкин М.И., Захаревич А.М., Гавриков М.В., Роках А.Г. ....	335
Спектрально-селективный источник на квантовых точках для ионизационных экспресс-анализаторов. Шишкин М.И., Ягудин И.Т. ....	340
Особенности свойств и возможности применений наночастиц узкозонных полупроводников. Жуков Н.Д., Хазанов А.А., Шишкин М.И., Ягудин И.Т.	345
Структуры для биосенсорики на основе Si/a-Si, полученные с помощью фотостимулированной адсорбции. Стецюра С.В., Козловский А.В., Сердобинцев А.А., Митин Д.М. ....	350
Исследование температурной зависимости удельного контактного сопротивления несплавных омических контактов к гетероструктуре AlGaN/GaN и к $n^+$ GaN. Павлов В.Ю., Павлов А.Ю., Слатовский Д.Н. ....	355
Изготовление HEMT на гетероструктурах AlGaN/AlN/GaN с применением технологии формирования сплавных омических контактов на основе Si/Al. Слатовский Д.Н., Павлов А.Ю., Павлов В.Ю., Клековкин А.В., Майтама М.В. ....	359
Влияние ионной имплантации на параметры приборных структур на основе GaN. Федоров Д.Г., Желаннов А.В., Селезнев Б.И. ....	363
Микроэлектронный газовый резистивный сенсор на основе нанокристаллических пленок диоксида олова с аддитивами тербия и сурьмы. Калугин С.М., Гуляев А.М., Строганов Д.А., Тевяшов А.А., Сарач О.Б., Котов В.А. ....	367
Резистивные газовые сенсоры на основе нанокристаллических пленок $\text{SnO}_2\text{-}x$ с аддитивами редкоземельных металлов. Котов В.А., Гуляев А.М., Сарач О.Б., Ануфриев Ю.В., Коновалов А.В. ....	372

Параметрическая активация микромеханических структур. <i>Ветров А.А., Калёнов В.Е., Корляков А.В., Михайлова О.Н., Сергуничев А.Н.</i>	377
Исследование квантоворазмерных полупроводниковых частиц, полученных методами химического и фотохимического травления. <i>Хазанов А.А., Цветкова О.Ю., Яшина Н.Ю.</i> .....	380
Нормально закрытые транзисторы на нитриде галлия. <i>Павлов А.Ю., Павлов В.Ю., Томош К.Н.</i> .....	385
Особенности постстрочной технологии формирования транзисторных структур на нитриде галлия. <i>Желаннов А.В., Селезнев Б.И.</i> .....	389
Методы формирования мезаструктур вертикально-излучающих лазеров. <i>Воропаев К.О., Селезнев Б.И.</i> .....	394
Преобразователь солнечной энергии на первовските. <i>Козырев Е.Н., Филоненко В.И., Беляева Т.Н., Сабанов В.Х., Гончаров И.Н., Ванеева Д.Д., Гордеев Г.О., Аскеров Р.О.</i> .....	398
Многослойные фотоникристаллические структуры на основеnano-структурированного пористого анодного оксида алюминия: исследования свойств. <i>Козырев Е.Н., Филоненко В.И., Беляева Т.Н., Гончаров И.Н., Кодзасова Т.Л., Аскеров Р.О., Баянкин Г.В.</i> .....	403
Исследование люминесцентных свойств пористого анодного оксида алюминия. <i>Филоненко В.И., Кодзасова Т.Л., Макоев Г.Т., Макоев Х.О., Сильев И.В., Дедегкаева Л.М.</i> .....	407
Преобразователь солнечной энергии в электрическую на основе CIGS. <i>Козырев Е.Н., Гаджиев Т.М., Рембеза С.И., Аскеров Р.О., Гордеев Г.О., Бекаури Э.Р.</i> .....	412
Состояние и проблемы совершенствования солнечных элементов. <i>Салказанов А.Т., Датиев М.К., Датиев К.М.</i> .....	417
Исследование энергетического спектра граничных состояний МДП-структур. <i>Гусалов А.И., Датиев К.М., Датиев М.К.</i> .....	421
Миниатюрный мощный импульсный нано/субнаносекундный оптический излучатель для дальнодействующих радаров высокого разрешения. <i>Земляков В.Е., Егоркин В.И., Вайнштейн С.Н., Маслевцов А.В., Wurz M.C., Филимонов А.В.</i> .....	427
Устройство для мониторинга дыхания и физической активности человека на основе интегрального акселерометра. <i>Гуденко Ю.А., Гутов А.З., Курданов Х.А., Лосанов Х.Х., Молоканов О.А.</i> .....	433
Устройство мониторирования электрокардиограммы и параметров артериального давления на основе мобильных технологий. <i>Гуденко Ю.А., Гутов А.З., Курданов Х.А., Лосанов Х.Х., Молоканов О.А.</i> .....	437

<b>Секция 4. Современные Информационные технологии в микро- и наноэлектронике .....</b>	<b>441</b>
Моделирование характеристик фоточувствительных элементов на основе поликристаллического сульфида свинца. <i>Мирошников Б.Н., Зезин Д.А., Роров Л.А.</i> .....	443
Моделирование процессов перезарядки и токопереноса в гетерофазных фотопроводящих структурах при облучении. <i>Харитонова П.Г., Стеценко С.В., Маляр И.В.</i> .....	447
Точный расчет наноразмерной системы Изинга во внешнем поле. <i>Алиев А.Р., Ахмедов С.А., Алиев Г.А., Алиев З.А.</i> .....	452
Динамика наночастицы при вращательном движении вблизи поверхности однородной поляризующейся среды. <i>Тленкопачев М.В., Уначев А.С.</i> .....	458
Уравнение эллипсометрии для однородной поглощающей пленки. <i>Калмыков Ш.А.</i> .....	461
Расчет некоторых физико-химических свойств стекол МКП. <i>Мискаров С.Г., Кудаев А.А., Лосанов Х.Х., Молоканова О.О., Шомахов З.В.</i> .....	469
<b>Указатели .....</b>	<b>472</b>
Авторский указатель .....	472
Указатель организаций .....	475
Указатель городов .....	476